

а 2013 0062

Изобретение относится к полупроводниковой технологии и может быть использовано для изготовления преобразователей солнечного излучения в электрическую энергию.

Способ роста структуры рInP-nCdS включает размещение предварительно протравленной рInP подложки с кристаллографической ориентацией (100) и разориентацией $3...5^\circ$ в направлении (110) в реактор, нагрев зоны роста подложки и стабилизацию температуры в диапазоне $400...450^\circ\text{C}$, распыление, в открытом потоке кислорода, растворов CdCl_2 и SnCl_4 с формированием на подложке слоя Cd_2SnO_4 , затем распыление растворов CdCl_2 и $\text{CS}(\text{NH}_2)_2$ с формированием на нем слоя nCdS.

П. формулы: 1